

гашение фотопроводимости в аморфном гидрированном кремнии, слабо легированном бором	1143	Quenching of Photoconduction in Amorphous Hydrogenated Silicon Lightly Doped by Boron	1143
Крещук А. М., Лаурс Е. П., Новиков С. В., Савельев И. Г., Семашко Е. М., Стовповой М. А., Шик А. Я. Инвертированная гетероструктура InP/In _{0.53} Ga _{0.47} As для полевого транзистора	1145	Kreshchuk A. M., Laurs E. P., Novikov S. V., Savel'ev I. G., Semashko E. M., Stovpovoi M. A., Shik A. Ya. InP/In _{0.53} Ga _{0.47} As Inverted Heterostructure for the Field-Effect Transistor	1145
Памяти Олега Вячеславовича Снитко	1148	In the memory of Oleg Vjacheslavovich Snitko	1148

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ
(ФТИ. 1990. Т. 24. В. 4. С. 610–630)

Стр.	Напечатано	Следует читать
612 (рис. 2)	[39]	[40]
615 (рис. 3)	[41]	[42]
» (рис. 4)	[44]	[45]
616 (рис. 5)	[45], [47], [58]	[46], [48], [60]
617 (рис. 6)	[49]	[50]
618 (рис. 8)	[44]	[45]
620 (рис. 11)	[41]	[42]
» (рис. 12)	[40]	[41]
621 (рис. 13)	[53]	[54]
» (рис. 14)	[54]	[55]
622 (рис. 15)	[54]	[55]
623 (рис. 16)	[60], [64]	[57], [58]
» (рис. 17)	[47]	[48]
» (рис. 18)	[60]	[62]
626 (рис. 19)	[60]	[62]
» (рис. 20)	[60]	[62]
627 (рис. 21)	[62]	[64]
» (рис. 22)	[63]	[65]
628 (рис. 23)	[62]	[64]